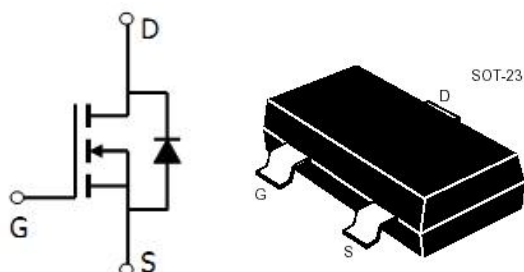


SOT-23 場效應晶體管(SOT-23 Field Effect Transistors)



N-Channel Enhancement-Mode MOS FETs

N 沟道增强型 MOS 场效应管

■ MAXIMUM RATINGS 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Voltage 漏極-源極電壓	BV_{DSS}	20	V
Gate- Source Voltage 柵極-源極電壓	V_{GS}	± 8	V
Drain Current (continuous) 漏極電流-連續	I_D	5	A
Drain Current (pulsed) 漏極電流-脉冲	I_{DM}	18	A
Total Device Dissipation 總耗散功率 $T_A=25^\circ\text{C}$ 環境溫度為 25°C	P_D	1250	mW
Junction 結溫	T_J	150	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature 儲存溫度	T_{stg}	-55to+150	$^\circ\text{C}$

■ DEVICE MARKING 打標

SI2310 = 2310

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Breakdown Voltage 漏極-源極擊穿電壓($I_D = 250\mu\text{A}, V_{GS}=0\text{V}$)	BV_{DSS}	20	—	—	V
Gate Threshold Voltage 柵極開啓電壓($I_D = 250\mu\text{A}, V_{GS} = V_{DS}$)	$V_{GS(th)}$	0.45	—	1.2	V
Diode Forward Voltage Drop 內附二極管正向壓降($I_S=0.75\text{A}, V_{GS}=0\text{V}$)	V_{SD}	—	—	1.5	V
Zero Gate Voltage Drain Current 零柵壓漏極電流($V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}= 16\text{V}$)	I_{DSS}	—	—	1	μA
Gate Body Leakage 柵極漏電流($V_{GS}=\pm 8\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$)	I_{GSS}	—	—	± 100	nA
Static Drain-Source On-State Resistance 靜態漏源導通電阻($I_D= 5\text{A}, V_{GS}= 4.5\text{V}$)	$R_{DS(ON)}$	—	22	24	$\text{m}\Omega$
Static Drain-Source On-State Resistance 靜態漏源導通電阻($I_D= 2\text{A}, V_{GS}= 2.5\text{V}$)	$R_{DS(ON)}$	—	28	30	$\text{m}\Omega$
Static Drain-Source On-State Resistance 靜態漏源導通電阻($I_D= 1\text{A}, V_{GS}= 1.8\text{V}$)	$R_{DS(ON)}$	—	38	45	$\text{m}\Omega$
Input Capacitance 輸入電容 ($V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}= 10\text{V}, f=1\text{MHz}$)	C_{ISS}	—	600	—	pF
Output Capacitance 輸出電容 ($V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}= 10\text{V}, f=1\text{MHz}$)	C_{OSS}	—	120	—	pF
Turn-ON Time 開啓時間 ($V_{DS}= 10\text{V}, I_D= 3\text{A}, R_{GEN}=6\Omega$)	$t_{(on)}$	—	8	—	ns
Turn-OFF Time 關斷時間 ($V_{DS}= 10\text{V}, I_D= 3\text{A}, R_{GEN}=6\Omega$)	$t_{(off)}$	—	60	—	ns

Pulse Width $\leq 300 \mu\text{s}$; Duty Cycle $\leq 2.0\%$

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [MOSFET](#) category:

Click to view products by [Yongyutai Electronics](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[IRFD120](#) [JANTX2N5237](#) [2SK2267\(Q\)](#) [BUK455-60A/B](#) [TK100A10N1,S4X\(S](#) [MIC4420CM-TR](#) [VN1206L](#) [NDP4060](#) [SI4482DY](#)
[IRS2092STRPBF-EL](#) [IPS70R2K0CEAKMA1](#) [TK31J60W5,S1VQ\(O](#) [TK31J60W,S1VQ\(O](#) [TK16J60W,S1VQ\(O](#) [2SK2614\(TE16L1,Q\)](#)
[DMN1017UCP3-7](#) [EFC2J004NUZTDG](#) [P85W28HP2F-7071](#) [DMN1053UCP4-7](#) [NTE2384](#) [DMC2700UDMQ-7](#) [DMN2080UCB4-7](#)
[DMN61D9UWQ-13](#) [US6M2GTR](#) [DMN31D5UDJ-7](#) [DMP22D4UFO-7B](#) [IPS60R3K4CEAKMA1](#) [DMN1006UCA6-7](#) [DMN16M9UCA6-7](#)
[STF5N65M6](#) [IRF40H233XTMA1](#) [STU5N65M6](#) [DMN6022SSD-13](#) [DMN13M9UCA6-7](#) [DMTH10H4M6SPS-13](#) [IPS60R360PFD7SAKMA1](#)
[DMN2990UFB-7B](#) [SSM3K35CT,L3F](#) [IPLK60R1K0PFD7ATMA1](#) [2N7002W-G](#) [MCAC30N06Y-TP](#) [IPWS65R035CFD7AXKSA1](#)
[MCQ7328-TP](#) [SSM3J143TU,LXHF](#) [DMN12M3UCA6-7](#) [PJMF280N65E1_T0_00201](#) [PJMF380N65E1_T0_00201](#)
[PJMF280N60E1_T0_00201](#) [PJMF600N65E1_T0_00201](#) [PJMF900N65E1_T0_00201](#)